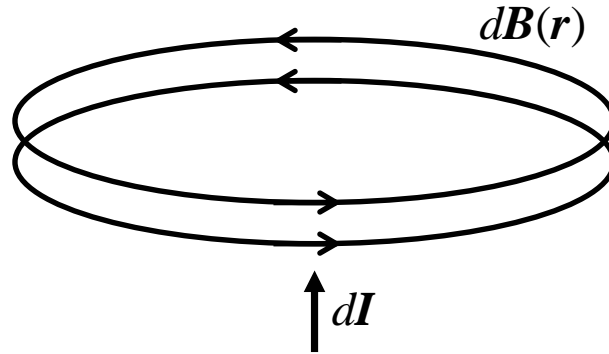


磁場の湧き出し

ビオ・サバルの法則より、電流要素 dI は回転対称な(トーラス型の)磁場を作る



どのような閉曲面 S をとっても、 $\int_S d\mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$

磁場の重ね合わせの原理より、一般に $\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$

これまでのまとめ

時間変化しない電磁場(静電場、静磁場)の基本法則

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q(\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \quad (\text{ローレンツ力})$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dV' \quad (\text{クーロンの法則})$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \epsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV & (\text{電場のガウスの法則}) \\ \oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 0 & (\text{循環ゼロの法則}) \\ \text{境界条件 (無限遠で電場がゼロに収束)} \end{cases}$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} dV' \quad (\text{ビオ - サバルルの法則})$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} & (\text{アンペールの法則}) \\ \int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0 & (\text{磁場のガウスの法則}) \\ \text{境界条件 (無限遠で磁場がゼロに収束)} \end{cases}$$

微分系への準備

その 1 : ガウスの定理

$$\int_S \mathbf{v}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) dV$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\partial v_x(\mathbf{r})}{\partial x} + \frac{\partial v_y(\mathbf{r})}{\partial y} + \frac{\partial v_z(\mathbf{r})}{\partial z} (\equiv \text{div } \mathbf{v}(\mathbf{r}))$$

「 $\nabla \cdot$ 」または「div」は「ダイバージェンス(divergence)」と読む

微分系への準備

その 1 : ストークスの定理

$$\oint_C \mathbf{v}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{v}(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \times \mathbf{v}(\mathbf{r}) \equiv \left(\frac{\partial v_z(\mathbf{r})}{\partial y} - \frac{\partial v_y(\mathbf{r})}{\partial z}, \frac{\partial v_x(\mathbf{r})}{\partial z} - \frac{\partial v_z(\mathbf{r})}{\partial x}, \frac{\partial v_y(\mathbf{r})}{\partial x} - \frac{\partial v_x(\mathbf{r})}{\partial y} \right)$$

($\equiv \text{rot } \mathbf{v}(\mathbf{r})$)

「 \times 」または「rot」は「ローテーション (rotation)」と読む

ガウスの法則の微分系

ガウスの定理 (数学)

ガウスの法則 (物理)

$$\int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) dV$$

$$\varepsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) dV = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

任意の体積 V で上の式が成り立つためには、積分の中身は同じでなければならないので、

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$$

アンペールの法則の微分系

ストークスの定理 (数学)

アンペールの法則 (物理)

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_V (\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\int_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$$

任意の閉曲面 S で上の式が成り立つためには、積分の中身は同じでなければならないので、

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r})$$

静電磁場の基本法則

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q(\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}))$$

< 微分形 >

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r})$$

< 積分形 >

$$\varepsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

$$\oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$$

マクスウェル方程式

時間変化する電磁場の基本方程式

$$\varepsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

$$\int_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r})}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \left(\mathbf{j}(\mathbf{r}) + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

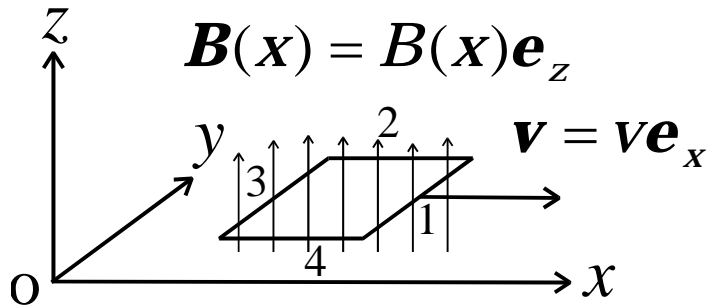
第4章

時間変化する電磁場

電磁誘導

導体内の電荷 q が受けるローレンツ力は

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= q\mathbf{v} \times \mathbf{B}(x) = qvB(x)\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z \\ &= -qvB(x)\mathbf{e}_y \end{aligned}$$



回路を一周する向きは、磁場の方向(今は z 軸)に対して右ねじの向きと約束する。

単位電荷が一辺の長さが a の回路を一周する際に受ける仕事 W 、を考える。

$$dW_1 = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -vB(x_1)a$$

$$dW_2 = 0$$

$$dW_3 = vB(x_3)a$$

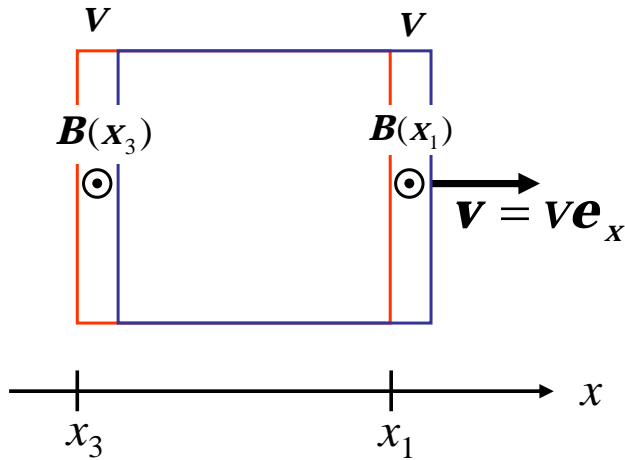
$$dW_4 = 0$$

よって、この回路に生じる誘導起電力 V は、

$$V = dW_1 + dW_3 = -va(B(x_1) - B(x_3))$$

誘導起電力

この回路を右ねじの向きに貫く磁束



$$\Phi \equiv \int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$$

単位時間あたりの変化量は、

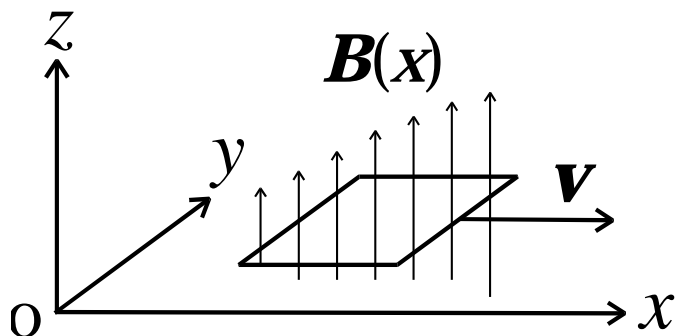
$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = vaB(x_1) - vaB(x_3) = va(B(x_1) - B(x_3))$$

よって、この回路に生じる誘導起電力は、

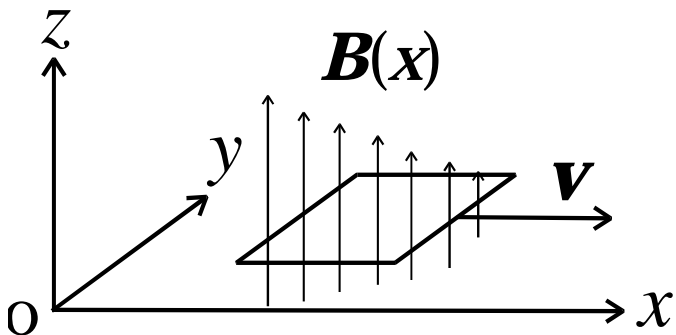
$$V = -\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

と表せる。

誘導起電力の向き (レンツの法則)



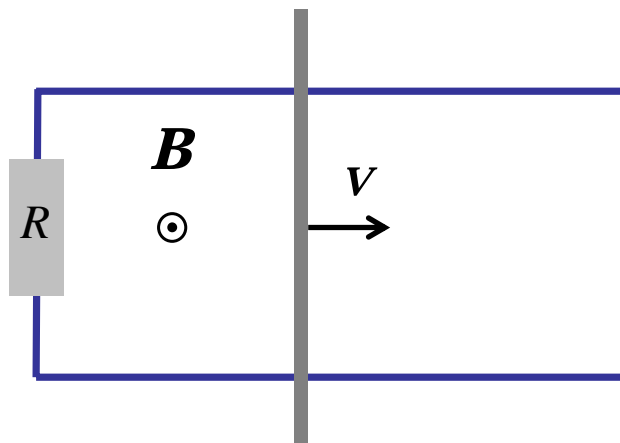
$\frac{\partial \Phi}{\partial t} > 0 \rightarrow V < 0 \rightarrow$ 電流は磁場に対して
右ねじの向きと逆に
流れる



$\frac{\partial \Phi}{\partial t} < 0 \rightarrow V > 0 \rightarrow$ 電流は磁場に対して
右ねじの向きに流れる

誘導起電力は、回路を貫く磁束の変化を打ち消す向きに生じる (レンツの法則)

誘導起電力が行う仕事の起源



単位時間あたりの回路を貫く磁束の変化量は

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = vaB = V \text{ (誘導起電力)}$$

回路に流れる電流 I は

$$I = \frac{V}{R} = \frac{vaB}{R}$$

棒に働くローレンツ力は、

$$F = aBI = aB \cdot \frac{vaB}{R} = \frac{va^2 B^2}{R}$$

よって、棒をローレンツ力に抗して速さ v で動かすために必要なパワーは、

$$P = Fv = \frac{(vaB)^2}{R}$$

よって、抵抗で消費される電力 P は

$$P = VI = \frac{(vaB)^2}{R}$$